

霍尔效应实验与磁阻测量

江灿 2019011325

清华大学 物理系, 北京 100084

【摘要】 霍尔效应是电磁效应的一种, 这一现象是美国物理学家霍尔 (E.H.Hall, 1855—1938) 于 1879 年在研究金属的导电机理时发现的。当电流垂直于外磁场通过半导体时, 载流子发生偏转, 垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场, 从而在半导体的两端产生电势差, 这一现象就是霍尔效应, 这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应在应用技术中特别重要。根据霍尔效应做成的霍尔器件, 就是以磁场为工作媒体, 将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出, 使之具备传感和开关的功能。

【关键词】 霍尔效应, 副效应, 磁阻测量

1 实验目的

- 1.1 了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理
- 1.2 掌握霍尔系数的测量方法, 学习消除霍尔效应的实验方法
- 1.3 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律

2 实验原理

2.1 霍尔效应

在一块长方形薄金属板两边对称点 1 和 2 之间接一个灵敏电流计 (如图 1), 沿着 x 轴正向通以电流 I 。若在 z 方向加上磁场 B , 电流计指针立即偏转, 说明 1, 2 两点间产生了电位差。霍尔发现此电位差与电流强度 I 和磁感应强度 B 均成正比, 与板厚度成反比, 即

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

其中 U_H 为霍尔电压, R_H 为霍尔系数, $K_H = R_H/d$ 为霍尔片的灵敏度。用洛伦兹力可说明此公式, 并可进一步得到

$$R_H = \frac{1}{ne}$$
$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

其中 e 为载流子电荷, n 为载流子浓度。 R_H 的单位是 m^3/c 。式 (2) 和式 (3) 对大多数金属均成立, 但对

霍尔系数较高的半导体材料, 公式中应引入以一霍尔因子 A 。在洛磁场的条件下, $A=3\pi/8$, 故

$$R_H = \frac{3\pi}{8} \frac{1}{ne}$$

本次实验为简化计算, A 近似为 1。

2.2 霍尔效应的副效应

实际情况下, 会有他一些副效应与霍尔效应混在一起, 使霍尔电压的测量产生误差, 因此必须尽量消除之。各种效应的特点如下:

2.2.1 厄廷好森效应

厄廷好森效应所引起的电位差 U_E 是指由于载流子以不同的速度在平行于 x 轴方向上运动, 因此在磁场作用下, 速度不同于平均速度的载流子在洛伦兹力与霍尔电场力的共同作用下, 向 y 轴方向的两侧偏移, 其动能在霍尔片的两侧转化为热能, 在两点间产生温差, 从而出现温差电动势 U_E 。 U_E 正比于 IB , 正负与 I, B 的方向有关。

2.2.2 能脱效应

能脱效应所引起的电位差 U_N 是指由于连接点 3, 4 处接触电阻不同而产生不同的焦耳热, 使 3, 4 两点温度不同, 从而使载流子在 x 方向的运动产生热流, 它在磁场作用下在 1, 2 两点间产生电位差 U_N 。 U_N 的符号与磁场 B 的方向有关。

2.2.3 里纪-勒杜克效应

里纪-勒杜克效应引起的电位差 U_R 是指由于上述热流中载流子速度各不相同, 在磁场作用下会使 1,2 两点出现温差电动势 U_R . U_R 方向与 B 的方向有关.

2.2.4 不等位效应

不等位效应引起的电位差 U_O 是指由于制作上的困难, 1,2 两点不可能恰好处在同一条等位线上, 因此只要样品中有电流通过, 即使 B 不存在, 1,2 两点间也会出现电位差 U_O . U_O 的正负只与电流方向有关, 其大小在磁场不同时也略不同.

2.2.5 实际测量

实际测量时, 由于仪表调整的状态, 及仪器电压受杂散电磁场和电源地线的影响, 电压表会有附加电压 U_S . U_S 与电流, 磁场方向无关.

当 I, B 确定后, 霍尔片上的输出电压应为上述几项的代数和

$$U = f(U_H, U_E, U_N, U_R, U_O, U_S)$$

2.2.6 副效应的消除方法

通过改变工作电流 I 的方向和外向磁场 B 的方向的不同组合测量课消除或减小 U_N, U_R, U_O 的影响. U_E 的变化与 U_H 变化相同, 不能用此法 22 消除, 当 U_E 等的值都小于 U_H , 实验测量中课略去. 消除上述副效应的重点是消除不等位效应 U_O .

2.3 磁电阻效应原理

一定条件下, 导电材料阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律称为磁阻效应. 磁电阻有各种类型, 其中正常磁电阻应用很普通, 铋化钢传感器是其中一种. 正常磁电阻情况下半导体内的载流子受洛伦兹力而偏移, 在两端集聚并形成霍尔电场. 若霍尔电场作用和某一速度的载流子所受的洛伦兹力刚好抵消, 则小于或大于该素的的电子将偏移, 沿外加电场方向运动的载流子数目减少, 电阻增大, 表现出横向磁电阻效应. 如图 2, 若 A,B 两端短接, 则霍尔电场不存在, 所有电子将向 A 端偏转, 也表现出磁电阻效应.

设磁阻器件在零磁场时电阻及电阻率分别为 $R(O), \rho(O)$, 磁场为 B 是电阻率分别为 $R(B), \rho(B)$. 以 $\delta\rho/\rho(O)$ 表示磁阻, $\delta\rho = \rho(B) - \rho(O)$, 而 $\delta R/R(O) \propto \delta\rho/\rho(O)$, 其中 $\delta R = R(B) - R(O)$. 磁场较弱时,

对正常磁阻器件 $\delta R/R(O) \propto B^2$, 而强磁场条件下 $\delta R/R(O)$ 为 B 的一次函数 (如图 3). 对于实验所用器件, $B \leq 0.06T$ 可看做弱磁场条件, $B \geq 0.12T$ 可看作为强磁场条件. $\delta R/R(O)$ 与电源输入端 C,D 的状态 (横流或恒压) 及 A,B 输出端是短路还是开路开关, 故实验结果应注明工作条件. 实验中推荐 C,D 端恒流, A,B 端短路的工作条件, 因此此时 $\delta R/R(O)$ 最大.

3 实验仪器

3.1 ZKY-HC 霍尔效应测试仪

包含恒流电源, 数字电压表, 励磁电流源

3.2 ZKY-HS 霍尔效应测试仪

包含三组换向开关, 电磁铁, 霍尔片, 磁电阻

3.3 万用表及导线

4 实验步骤

1. 测量霍尔片输出电压 U_H 与输入电流 I 的关系曲线, 要求电流源 2.00 8.00mA, 间隔 1.00mA, 每个测量点测 $U_1(+B, +I_H), U_2(+B, -I_H), U_3(-B, -I_H)$, 和 $U_4(-B, I_H)$ 4 组数据. 可证 $U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$ 课后画出 $U_H - I$ 关系曲线, 计算 K_H, R_H, n 的数值和不确定度, 并给出不等位效应 U_O 的表示方法.
2. 标定激励电流 $I_M(0 \sim 800mA)$ 与磁极间磁场 B 的关系.
3. 研究铋化钢磁阻器件的磁电阻效应. C,D 端恒流, A,B 端短路, $I_{CD}=1.50mA$, 测磁电阻 $\delta R/R(O)$ 随磁场变化规律, $I_M: 0 \sim 1000mA$, 间隔 50 100mA, 前 6 8 个点为非线性区, 间隔 50mA, 后面为线性区, 间隔 100mA.
4. 测定磁极间隙水平方向磁场的分布曲线 $B - X, I_O = 4.00mA, I_M = 500mA$.
5. 判定霍尔片载流子的类型是空穴还是电子. 实验中记录下 U_H, I, B 的方向
6. 测霍尔片中载流子的迁移率. 实验时不加磁场, 霍尔片工作电流 0 8.00mA 改变, 同时测量 C,D 端的电压.

5 注意事项

1. 避免霍尔元件及二维移动标尺受挤压, 碰撞等, 实验前检查两者及电磁铁位置并调整。
2. 实验前应将霍尔元件移至电磁铁气隙中心, 并使其平面都与磁场方向垂直, 以使 U_H 最大。
3. 在不需要的时候断开励磁电流开关。

6 实验数据

6.1 U_H 与 I 关系及 K_H, R_H, n 的计算

由实验室提供的表格查得 $I_M=500\text{mA}$ 时, $B_0=123.7\text{mT}$ 由实验所测得数据制作的 $U_H - I$ 关系曲线如图

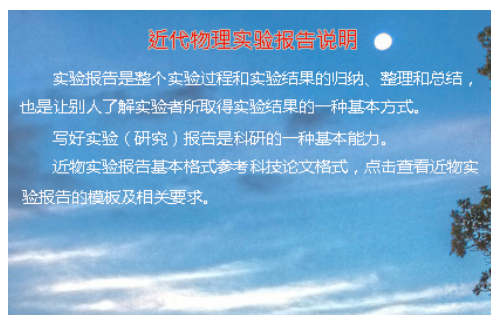


图 1 $U_H=I$

可见, U_H, I 成线性关系。

直线斜率 $k=23.30714275$, 相关系数 $r=0.9999901842$

由 $U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$, 故 $k = \frac{R_H B}{d} = K_H$, 所以有

$$R_H = \frac{kd}{B} = \frac{23.30714275 \times 3 \times 10^{-6}}{123.7 \times 10^{-3}} \approx 5.65239 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}/T$$

$$K_H = \frac{k}{B} = 188.4156 \Omega/T$$

$$\delta k = S_K = k \sqrt{\frac{1}{n^2 - 2}} \approx 0.04607 \Omega$$

$$\delta R_H = \frac{d}{B} \delta k \approx 1.1 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}/T$$

$$\delta K_H = \frac{1}{B} \delta k \approx 0.4 \Omega/T$$

故

$$R_H = (5.653 \pm 0.011) \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}/T$$

$$K_H = (188.4 \pm 0.4) \Omega/T$$

又 $R_H = \frac{1}{ne}$, 故

$$n = \frac{1}{R_H e} = 1.1031 \times 10^{22} \text{m}^{-3}$$

$$\delta n = \frac{\delta R_H}{R_H^2 e} \approx 2.1 \times 10^{19} \text{m}^{-3}$$

故

$$n = (1.1031 \pm 0.0021) \times 10^{22} \text{m}^{-3}$$

不等位效应 U_0 的确定: 由实验原理 $U = f(U_H, U_E, U_N, U_R, U_O, U_S)$, f 表示求和, 式中 U_E 很小可略去, 故 $U = f(U_H, U_E, U_N, U_R, U_O, U_S) = U_H + U_N + U_R + U_P + U_S$

不妨设 $+B, +I$ 的条件下参与求和的各电压均取正值

由于 U_H 正负与 I, B 方向有关, U_N, U_R 正负只与 B 方向有关, U_O 方向只与 I 方向有关, U_S 与 I, B 无关, 故

$$U_1(+B, +I_H) = f(U_H, U_N, U_R, U_O, U_S)$$

$$U_2(+B, +I_H) = f(-U_H, U_N, U_R, -U_O, U_S)$$

$$U_3(+B, +I_H) = f(U_H, -U_N, -U_R, -U_O, U_S)$$

$$U_4(+B, +I_H) = f(-U_H, -U_N, -U_R, U_O, U_S)$$

所以

$$\frac{1}{4}(U_1 + U_3 - U_2 - U_4) = U_H$$

$$\frac{1}{4}[(U_1 - U_2) - (U_3 - U_4)] = U_O$$

故

$$U_O = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4)$$

现将实验 1 中各结果整理如下

$$R_H = (5.653 \pm 0.011) \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}/T, K_H = (188.4 \pm 0.4) \Omega/T$$

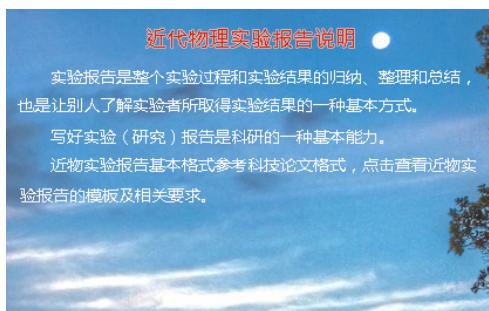
$$n = (1.1031 \pm 0.0021) \times 10^{22} \text{m}^{-3}, U_O = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4)$$

6.2 标定 I_M 与 B 的关系

有实验数据可得

$$B = \frac{U_H}{K_H I}, I = 4.00 \text{mA}, K_H = 188.4 \Omega/T$$

由此可作出 $B-I_M$ 曲线,

图 2 $B-I_M$

由曲线可以看出 B 与 I_M 成线性 (基本为正比) 关系, 这与理论相符. 用计算器可求得拟合直线的方程:

$$B = 0.4065 + 0.2472I_M$$

I_M 的单位为 mA, B 单位为 mT. 相关系数 $r=0.99999243$

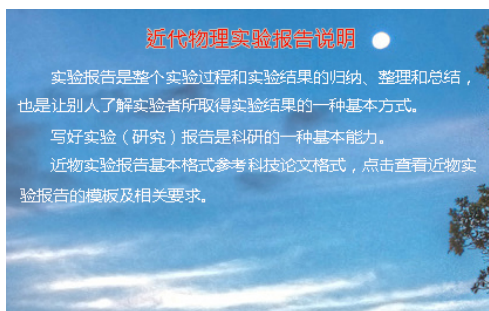
6.3 铽化铟磁阻器件的磁电阻效应

由实验数据整理得

$$R(B) = \frac{U_{CD}}{I}, I = 1.50mA,$$

$$\delta R = R(B) - R(O), B = 0.4065 + 2472I_M (mT)$$

由此可绘出 $\delta R/R(O)$ B 的关系曲线

图 3 $\delta R/R(O)$ B

由曲线走势进行如下回归分析:

取前六点进行二次回归, 有

$$\delta R/R(O) = 0.0803B^2 + 1.2452B - 5.0797, r^2 = 0.9991$$

相关程度高

取后六点进行线性回归, 有

$$\delta R/R(O) = 2.9426B + 414.32, r^2 = 0.9989$$

相关程度较高

于是在磁场较弱时, $\delta R/R(O)$ 与 B 有着二次函数的关系, 曲线为抛物线. 磁场较强时, $\delta R/R(O)$ 存在线性关系, 曲线为直线.

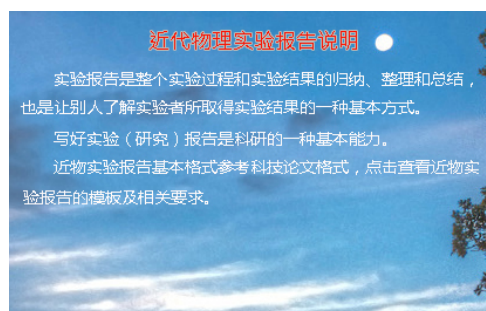
抛物线与直线间光滑过渡. 与原理中部分内容符合较好

6.4 磁极间隙水平方向磁场的分布曲线

由实验数据整理得:

$$B = \frac{U_H}{K_H I}, I = 4.00mA, K_H = 1.884\Omega/T$$

实验时的励磁电流 $I_M = 500mA$ 由此可作出实验曲线

图 4 $B \times$

曲线有对称性, 对称轴大致在气隙中心位置. 从曲线中可以看出, 随着 x 的增大, B 先是逐渐增大到某个值, 在一定范围内保持恒定, 然后又逐渐减小. 增加的速度先慢后快, 后由快变慢. 下降的速度亦然.

从曲线中可以看出, 电磁铁气隙中心的磁场为均匀磁场, 且磁感应强度最大.

6.5 判断载流子类型

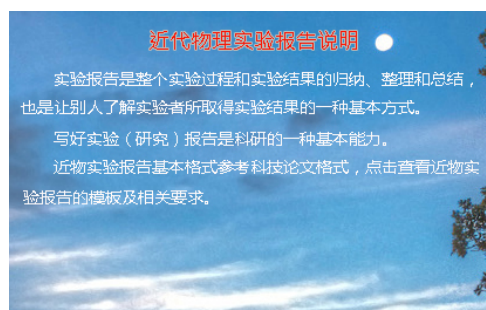


图 5 载流子

电流方向如图中标示. 由左手定则, 不管载流子是电子和空穴, 均会发生向下的偏转. 有由于 3

正文文字中先见文,后见图,图号全文统一按顺序编号,如图7所示。图中文字为6号,图线必须清晰可辨坐标轴的物理量和单位不可缺。

6.10 报告中表的规范

推荐使用标准“三线表”(如表1所示。),内容易混淆时可加辅助线进行辅助说明。按表格在文中出现的顺序,用阿拉伯数字对其进行编号,全文顺序编号。应有相应的表题且每个表格前都应有相应的引出或介绍文字。

图、表应在文中有相应表述,即图、表的号应在文中引出,以先见文后见图、表为原则。每个图、表都必须有图名、表名,并且有编号。图号、表号应全文统一连续排列,即,应按照图1、图2……排列不应按小结编号。图片中的文字、线条应当清晰可辨,图片像素(DPI)在300以上。表格推荐采用全列表,表头中使用量符号/量单位形式。如表2所示。

表1 三线表示例

编号	直径/m	静温/K	时间/min
4	0.0349	268.15	30
5	0.01905	268.15	30

表2 全列表示例

U/V	I/mA	$v/\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$	x/mm	p/MPa
12	30	80	55	110
24	34	90	60	111

6.11 报告中英文缩略语的规范

文中的英文缩略语应在首次出现时给出中文含义以及英文全称后再使用。例如,全球定位系统(Global Positioning System, GPS)。

6.12 外文字母

6.12.1 斜体外文字母用于表示量的符号,主要用于下列场合

- (1) 变量符号、变动附标及函数。
- (2) 用字母表示的数及代表点、线、面、体和图形的字母。
- (3) 特征数符号,如 Re (雷诺数)、Fo (傅里叶数)、Al (阿尔芬数) 等。

(4) 在特定场合中视为常数的参数。

6.12.2 正体外文字母用于表示名称及与其有关的代号,主要用于下列场合

- (1) 有定义的已知函数 (例如 \sin , \exp , \ln 等)。
- (2) 其值不变的数学常数 (例如 $e = 2.7182818\cdots$) 及已定义的算子。
- (3) 法定计量单位、词头和量纲符号。
- (4) 数学符号。
- (5) 化学元素符号。
- (6) 机具、仪器、设备和产品等的型号、代号及材料牌号。
- (7) 硬度符号。
- (8) 不表示量的外文缩写字。
- (9) 表示序号的拉丁字母。
- (10) 量符号中为区别其他量而加的具有特定含义的非量符号下角标。

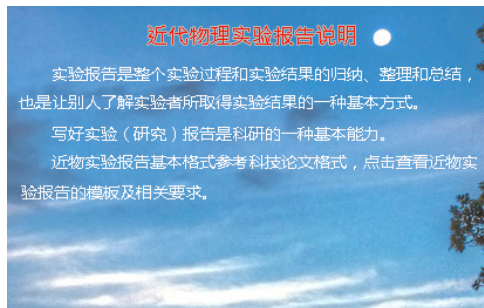


图7 图片示例

7 思考题

7.1 如何计算实验中霍尔片载流子迁移率

由“实验数据处理”, $\mu = \Omega R_H$, 其中 Ω 为霍尔片的电导率, R_H 为霍尔系数. 具体计算过程将数据处理部分。

7.2 如何观察不等位效应? 如何消除不等位效应对测量带来的影响?

将电磁铁的激励电流切断, $B=0$, 此时霍尔片两侧面间仍有电位差. 改变电流 I_H 的方向, 此电位差正负改变, 这就是观察不等位效应的方法. 测量

出 $(+B, +I_H), (+B, -I_H), (-B, I_H), (-B, -I_H)$ 下的电势差 U_1, U_2, U_3, U_4 , 并按式 $U_H = \frac{1}{4}U_1 - U_2 + U_3 - U_4$ 计算即可消除不等位效应, 理由在数据处理部分已经给出.

7.3 如何利用霍尔效应测量磁场?

给霍尔片通以电流 I , 测出片上的霍尔电压 U_H , 即可通过式 $B = \frac{U_H}{K_H I}$ 计算出磁场, K_H 用实验的方法确定.

8 实验总结

通过这次实验, 我对于霍尔效应有了更加直观, 深入的认识. 学会了消除霍尔副效应的方法. 本次实验内容丰富, 各个小实验之间联系密切, 前面实验的结构直接影响到了后面的实验. 这让我对物理实验的方法有了更深刻的认识, 对物理现象内在的联系有了进一步的体会.

参考文献